

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行專訴字第3號

民國114年7月23日辯論終結

原告 美商杜邦電子材料控股公司
代表人 布雷克 T. 彼得門
訴訟代理人 呂紹凡律師（兼上一人及次二人送達代收人）
洪珮瑜專利師
翁啟達專利師
被告 經濟部智慧財產局
代表人 廖承威
訴訟代理人 簡昭莢
參加人 巴秀蓉
訴訟代理人 彭國洋律師（兼上一人及次三人送達代收人）
複代理人 李秉濤專利師
訴訟代理人 黃國彰律師
蔡孟彤律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年11月22日經法字第11317304880號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

- 一、原告之訴駁回。
- 二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

- 一、原告原起訴聲明第二項為：「被告應就中華民國專利公告號第I482789B號發明專利為請求項1至8『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第18頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年4月2日具狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第425至426頁），核於公益之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。

01 二、參加人於本件行政訴訟得爭執第陸、一至三項爭點：

02 參加人提起本件舉發時所提之舉發理由，除系爭專利請求項
03 1至8不具進步性外，尚包括系爭專利說明書有違專利法第26
04 條第1項規定、系爭專利請求項1至8有違同法第26條第2項規
05 定、以及原證2足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性之
06 爭點（即第陸、一至三項爭點），經原處分以系爭專利說明
07 書未違同法第26條第1項規定、系爭專利請求項1至8未違同
08 法第26條第2項規定、以及原證2不足以證明系爭專利請求項
09 1至8不具新穎性，但系爭專利請求項1至8不具進步性，作成
10 舉發成立之審定，因審定結果已達參加人之舉發目的，致參
11 加人就有關同法第26條第1項、第2項及新穎性之爭點不得提
12 起救濟，為免發生同一爭點循環訴訟之情形，基於紛爭解決
13 一次性及訴訟經濟之考量，本院准許參加人於本件行政訴訟
14 就有關同法第26條第1項、第2項及新穎性之爭點再為爭執，
15 並命兩造及參加人應就此進行實體攻防（本院卷二第267
16 頁）。

17 貳、爭訟概要：

18 原告（原名羅門哈斯電子材料CMP控股公司）前於98年7月14
19 日以「化學機械研磨墊」向被告申請發明專利，申請專利範
20 圍計8項，並以西元2008年8月5日申請之美國第12/221581號
21 專利案主張優先權，經被告准予專利（公告號第I482789
22 號，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利
23 法第22條第1項第1款、第2項及第26條第1項、第2項規定，
24 對之提起舉發；原告則於民國111年4月8日提出系爭專利申
25 請專利範圍更正本。被告認上開更正符合規定，並認系爭專
26 利請求項1至8違反同法第22條第2項規定，以113年4月16日
27 （113）智專議（四）01146字第00000000000號專利舉發審
28 定書為「111年4月8日之更正事項，准予更正」、「請求項1
29 至8舉發成立，應予撤銷」之處分。原告就原處分關於舉發
30 成立部分不服，提起訴願，經經濟部以同年11月22日經法字

第000000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟之結果，如認應撤銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、原證2（證據2）、原證3（證據3）、原證4（證據9）、原證5（證據10）及原證6（證據11）均至少未揭露系爭專利請求項1及5「wt%a為3.25重量%至3.6重量%」、及「粗化表面能於研磨過程中捕獲燻矽顆粒」之技術特徵，無從證明系爭專利請求項1至8不具進步性。又原證2為被告於103年4月10日審查意見通知函所載引證案TZ000000000A之中國對應案，兩案內容實質相同，被告曾據以主張系爭專利不具進步性，但經原告修正申請專利範圍及申復說明後，被告亦肯認系爭專利之進步性，顯見被告已自認原證2無從證明系爭專利請求項1至8項不具進步性。

二、原證2明確排除製劑B，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將原證2與其所明確排除之技術內容組合。又系爭專利之研磨墊可同時達成：低缺陷、高移除速度，良好的晶片一致性、捕獲燻矽顆粒等功效，系爭專利已有數據證實其功效，且該些功效非可由先前技術所預期。而原證7至原證10可作為判斷系爭專利具有進步性之依據，且其已證實系爭專利具有無法預期之功效。

三、系爭專利說明書第16頁已以實施例明確揭露本案研磨墊之製造方法，並以實施例證明，顯無違反專利法第26條第1項規定。又系爭專利請求項1至8已明確記載研磨墊之技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者由請求項之記載內容，即可瞭解其意義，並可由說明書相應之記載，諸如實施例，確認系爭專利請求項1至8之記載，且請求項1至8所請範圍可為說明書所支持，並無違反同條第2項規定。

01 四、原證2至少未揭露系爭專利請求項1及5之技術特徵：「wt%為
02 3.25重量%至3.6重量%」及「粗化表面能於研磨過程中捕獲
03 燻矽顆粒」，故原證2無從證明系爭專利請求項1及5不具新
04 穎性。

05 五、聲明：

06 訴願決定及原處分關於「請求項1至8舉發成立」之部分均撤
07 銷。

08 肆、被告答辯要旨及聲明：

09 一、雖然原證2僅揭示「1.07重量%~3.21重量%」聚合物微球體
10 的含量範圍，並未揭示系爭專利請求項1之「3.25重量%至3.
11 6重量%」範圍，但本發明所屬技術領域中具有通常知識者係
12 可輕易調整包含聚合物基質與中空聚合物顆粒的研磨墊成分
13 中任何一成分含量的多寡，況原證2下標第12頁最末段已揭
14 示聚合物微球體的量的增加會改進拋光缺陷度性能，故所屬
15 技術領域中具有通常知識者為進一步改善拋光缺陷度，有動
16 機提高聚合物微球體的含量。再者，由原證2表5中B-1至B-3
17 （呈等比例關係）實施例所呈之功效，整體觀其平均TEOS
18 去除速率、振痕、划痕以及選擇性之數值，明顯得知隨著微
19 球含量增加，研磨墊整體隨之具有較優異的效果，據此，所
20 屬技術領域中具有通常知識者有動機將原證2之3.21重量%再
21 行提高微球含量。

22 二、原證2製劑B之平均撕裂強度雖未在其請求項1所載之範圍
23 內，即其為該發明之比較例關係，但不影響原證2製劑B（尤
24 其是B-1的3.21重量%）已公開之事實。雖原證2製劑B之平均
25 撕裂強度146磅/英寸不及請求項1至少為250磅/英寸之目
26 的，但反觀其抗張強度7617psi，則符合至少6500psi之目
27 的。又原證2之比較例僅為該發明效果相較於其實施例為
28 差，不必然表示所屬技術領域中具有通常知識者不會參考該
29 比較例進而簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而提高微
30 球含量。綜上，原證2、原證2與原證3之組合、原證2、原證

3與原證4之組合、原證2、原證3與原證5之組合、以及原證2、原證3與原證6之組合，均足以證明系爭專利請求項1不具進步性。至原告所提原證8至10並無法確定是否於系爭專利申請時既已存在，而非事後所得之數據。退萬步言，該等數據亦無法證明系爭專利具有「無法預期」之功效。

三、原告所提原證8至10之相關數據，聲稱系爭專利確實具有無法預期之功效，惟該等數據並無法確定是否於系爭專利申請時既已存在，而非事後所得之數據。退萬步言，該等數據亦無法證明系爭專利具有「無法預期」之功效。

四、聲明：

駁回原告之訴。

伍、參加人答辯要旨及聲明：

一、系爭專利說明書關於「密度b係5g/L至500g/L之平均密度」、「中空聚合物顆粒平均密度」、「聚合基質形成環繞閉合單元結構之連續網」之揭露未盡充分，亦不明確，致無法為所屬技術領域之通常知識者據以實現，有違專利法第26條第1項規定。

二、系爭專利請求項1、5關於「該聚合基質形成環繞該閉合單元結構之連續網」之記載不明確；系爭專利請求項1關於「中空聚合物顆粒具有的密度b係5g/L至500g/L之平均密度」，以及系爭專利請求項5關於「中空聚合物顆粒具有的密度b係10g/L至300g/L之平均密度」之記載均無法為系爭專利說明書所支持；系爭專利請求項1、5關於「wt%a係3.25重量%至3.6重量%」之記載無法為系爭專利說明書所支持。故系爭專利請求項1至8記載不明確，且無法為系爭專利說明書所支持，有違專利法第26條第2項規定。

三、原證2事實上已隱含揭示微球體（即中空聚合物顆粒）含量重量百分比係介於3.25~3.6之間。又「粗糙化表面能於研磨過程中捕獲燻矽顆粒」係屬功能性子句，對於請求項界定之範圍不具限定作用；原證2事實上已隱含揭示「粗糙化表

面能於研磨過程中捕獲燻矽顆粒」技術特徵。此外，系爭專利請求項5同請求項1亦在請求保護一種研磨墊，其與請求項1所載技術手段差異僅在於「該聚合物基質係NH₂對NCO之化學計量比率為80%至90%之固化劑」、「密度係10g/L至300g/L之平均密度」及「該研磨墊具有35體積%至55體積%之孔隙率」三項技術特徵。然所述三項差異技術特徵實已為原證2所揭示（詳參舉發理由書第65至69頁），故原證2足以證明系爭專利請求項5不具新穎性。

四、系爭專利請求項1所載「wt%為3.25重量%至3.6重量%」技術特徵，為所屬技術領域具有通常知識者，可在參酌原證2之基礎上，透過簡單變更微調增加聚合物微球體含量輕易完成。又所屬技術領域具有通常知識者在參酌原證2之基礎上，於思考如何改進拋光缺陷度性能，並提升平均TEOS去除速率時，並不會排除B製劑之使用。另系爭專利請求項1所載技術手段相較原證2揭示之技術內容並不具有無法預期之功效。綜上，系爭專利請求項1所載整體技術手段為所屬技術領域具有通常知識者依原證2所揭示之技術內容可輕易完成，原證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。基此，原證2、3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及5之組合；原證2、3及6之組合均足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

五、聲明：

駁回原告之訴。

陸、爭點（本院卷二第222至223頁）：

- 一、系爭專利說明書有無記載不明確、未充分揭露，致無法據以實現，有違專利法第26條第1項規定？
- 二、系爭專利請求項1至8有無記載不明確，且無法為說明書所支持，有違專利法第26條第2項規定？
- 三、原證2是否足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性？

01 四、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
02 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
03 項1不具進步性？

04 五、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
05 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
06 項2不具進步性？

07 六、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
08 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
09 項3不具進步性？

10 七、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
11 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
12 項4不具進步性？

13 八、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
14 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
15 項5不具進步性？

16 九、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
17 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
18 項6不具進步性？

19 十、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3及
20 5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利請求
21 項7不具進步性？

22 十一、原證2；原證2及3之組合；原證2、3及4之組合；原證2、3
23 及5之組合；或原證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利
24 請求項8不具進步性？

25 柒、本院的判斷：

26 一、應適用的法令：

27 (一)系爭專利於98年7月14日申請，以97年8月5日為優先權日，
28 於104年1月8日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原
29 因，應依核准時所適用之103年3月24日修正施行之專利法
30 (下稱專利法)。

(二)依專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。另同法第26條第1、2項規定：「（第1項）說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。（第2項）申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」此外，發明專利權有違反同法第22條第1項、第2項、第26條規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，自應為舉發成立之處分。

二、確定申請專利之發明範圍：

系爭專利所欲解決的問題、申請專利範圍如附表1所示，請求項1、5之要件特徵解析如附表3、4所示。

三、確定相關先前技術所揭露之內容：

參加人所提引證為原證2至6（舉發證據編號分別為證據2、3、9至11，如附表2所示。以下僅稱原證2至6），其公告、公開皆早於系爭專利優先權日（97年8月5日），可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。

四、系爭專利說明書記載明確且充分揭露而可據以實現，並未違反專利法第26條第1項規定：

(一)系爭專利說明書第8頁記載研磨墊與其應用，第9至12頁記載研磨墊所含聚合物基質組成份及製備方式，第12至13頁記載研磨墊所含中空聚合物顆粒的重量平均直徑、形狀、平均密度、質量及基於等量孔體積的關係式，第14至15頁記載研磨墊之孔隙率及結構，可知系爭專利說明書應已明確且充分揭露研磨墊相關技術內容。再者，系爭專利說明書第16至22頁

01 以實施例揭露研磨墊之製造與測試結果，具體記載所使用之
02 聚合物墊材料、中空聚合物微球種類與其等之比例等，是系
03 爭專利說明書亦已提供實施例，更足認得據以製造及使用系
04 爭專利之發明。因此，對於系爭專利請求項1至8所請研磨
05 墊，所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利說明書、申
06 請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知
07 識，無須過度實驗，即能瞭解申請專利之發明內容，並可據
08 以實現該發明，並無違反專利法第26條第1項規定。

09 (二)參加人主張就「密度b係5g/L至500g/L之平均密度」，系爭
10 專利說明書僅提供平均密度為60g/L及42g/L之中空聚合物微
11 球的實施例，未以實驗證明具有所述平均密度b兩端點值5g/
12 L及500g/L的他種中空聚合物微球對於實現其發明所欲達成
13 之功效皆確屬可行，亦未說明前開範圍如何得出，系爭專利
14 說明書不足以支持請求項1所載權利範圍均可實現云云。

15 1.當一請求項之範圍涵蓋較廣，其說明書必須給予一定數量
16 的實施方式或實施例，以延伸涵蓋請求項之全部範圍，反
17 之，當說明書已提供足夠資訊，使該發明所屬技術領域中
18 具有通常知識者，參酌申請時之通常知識即可實現該發
19 明，則有限數量（甚至僅需一個）之實施方式或實施例，
20 亦足以支持一廣泛的請求項之範圍。易言之，判斷系爭專
21 利說明書是否可據以實現系爭專利所載「密度b係5g/L至5
22 00g/L之平均密度」之範圍，並非以系爭專利說明書兩端
23 點值均提供實施例為必要，有限數量甚至僅需一個之實施
24 方式或實施例亦可能得以支持該範圍。

25 2.系爭專利說明書已具體例示EXPANCEL®551DE20d60（平均
26 密度為60g/L）及551DE40d42及（平均密度為42g/L）等中
27 空聚合物微球之使用，並於第13頁說明在使用不同尺寸及
28 類型的中空聚合物顆粒時，如何確定其質量以給出等量孔
29 體積，是所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利說明
30 書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時

之通常知識，無須過度實驗，即能於製備研磨墊時採用平均密度在5g/L至500g/L範圍之他種中空聚合物微球，並產生預期的功效，堪認系爭專利說明書就此部分之揭露已屬充分、明確而可據以實現系爭專利所請發明。

(三)參加人另主張系爭專利說明書關於「中空聚合物顆粒平均密度」之說明並非標準測量單位，無從瞭解其具體含義，另關於「聚合基質形成環繞閉合單元結構之連續網」亦無說明其意義、具體結構及如何形成，對於前開內容之記載欠缺明確、且未充分揭露，致無法據以實現云云。

1.關於「中空聚合物顆粒平均密度」部分，系爭專利說明書第13頁記載「此等中空聚合物顆粒典型係具有60g/公升(L)之平均密度。為了本說明書之目的，該中空聚合物顆粒之平均密度係表示於1公升體積內，該中空顆粒之緊密封裝未破碎密度(close-packed-non-crushed density)」，應已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者理解中空聚合物顆粒平均密度之意義，亦即指顆粒於一公升體積內以「緊密但未破碎」之程度堆積所得到的密度值，而「密度」、「緊密封裝未破碎」等用語的技術意義亦為發明所屬技術領域中具有通常知識者所公知，堪認系爭專利說明書就此部分之揭露已屬充分、明確而可據以實現系爭專利所請發明。

2.又關於「聚合基質形成環繞閉合單元結構之連續網」部分，系爭專利說明書第9頁記載「該預聚物產物係以選自包含固化多胺、固化多元醇、固化醇胺及其混合物之群組之固化劑固化，以形成研磨墊」，第12頁記載「該中空聚合物顆粒於整個聚合物基質中提供隨機之孔分佈。特別地，該研磨墊具有閉合單元結構，且該聚合物基質形成環繞該閉合單元結構之連續網」，應已足使發明所屬技術領域中具有通常知識者理解所述結構之意義、結構及形成方法。況且，參加人業於舉發階段所提舉發理由書第42頁陳

01 稱「中空聚合物顆粒在拋光墊中本身即形成了閉合單元結
02 構，因此所屬領域具有通常知識者可以毫無疑義的確定：
03 中空聚合物顆粒與預聚物固化後自然會形成閉合單元結構
04 分佈於聚合物基質內的拋光墊，即聚合物基質內的閉合單
05 元結構形成圍繞閉合單元結構的連續網」，足徵參加人亦
06 肯認對於所屬領域具有通常知識者而言，採用中空聚合物
07 顆粒與預聚物固化自然會獲得「聚合基質形成環繞閉合單
08 元結構」之結果，故系爭專利說明書就此部分之揭露應已
09 屬充分、明確而可據以實現系爭專利所請發明。

10 五、系爭專利請求項1至8記載明確且可為說明書所支持，並未違
11 反專利法第26條第2項規定：

12 (一)系爭專利請求項1至8業已敘明研磨墊之成分、結構等技術特
13 徵，發明所屬技術領域中具有通常知識者應可明確瞭解其意
14 義而對其範圍不會產生疑義。另系爭專利說明書業已揭露研
15 磨墊相關技術內容，並提供實施例，是發明所屬技術領域中
16 具有通常知識者參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或
17 分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至系爭
18 專利請求項1至8之範圍，此等請求項可為說明書所支持。因
19 此，系爭專利請求項1至8並無違反專利法第26條第2項規
20 定。

21 (二)參加人主張請求項1、5所載「該聚合基質形成環繞閉合單元
22 結構之連續網」並說明其意義、具體結構及如何形成，對於
23 前開內容之記載不明確致使所屬技術領域中具有通常知識者
24 無法明確瞭解其意義云云。惟由於發明所屬技術領域中具有
25 通常知識者可理解「該聚合基質形成環繞閉合單元結構之連
26 續網」之意義、結構及形成方法，且參加人亦已於舉發階段
27 所提舉發理由書中肯認對於所屬領域具有通常知識者而言，
28 採用中空聚合物顆粒與預聚物固化自然會獲得「聚合基質形
29 成環繞閉合單元結構」之結果，業如前述，足認發明所屬技
30 術領域中具有通常知識者可明確瞭解請求項1、5所述「該聚

01 合基質形成環繞閉合單元結構之連續網」而對其範圍不會產
02 生疑義，是以該等請求項及其附屬項尚無參加人所指之不明
03 確等情。

04 (三)參加人又主張請求項1所載「中空聚合物顆粒具有的密度b係
05 5g/L至500g/L之平均密度」、請求項5所載「中空聚合物顆
06 粒具有的密度b係10g/L至300g/L之平均密度」及請求項1、5
07 所載「wt%a係3.25重量%至3.6重量%」無法為說明書所支持
08 云云。然查：

09 1.由於系爭專利說明書已具體例示 EXPANCEL®551DE20d60（
10 平均密度為60g/L）及551DE40d42（平均密度為42g/L）等
11 中空聚合物微球之使用，並說明在使用不同尺寸及類型的中
12 空聚合物顆粒時，如何確定其質量以給出等量孔體積，
13 詳如前述，則發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申
14 請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，應可由說
15 明書揭露的內容合理預測或延伸至系爭專利請求項1至8之
16 範圍，亦即於製備研磨墊時採用平均密度在5g/L至500g/L
17 範圍或10g/L至300g/L範圍之他種中空聚合物微球，並產
18 生預期的功效，故此部分並無參加人所指之無法為說明書
19 所支持等情。

20 2.再者，系爭專利說明書第12至13頁記載研磨墊所含中空聚
21 合物顆粒的重量平均直徑、形狀、平均密度、質量及基於
22 等量孔體積的關係式，第16至22頁以實施例具體例示混合
23 3.36wt%之EXPANCEL®551DE20d60（平均密度為60g/L）中
24 空聚合物微球所製得之研磨墊，則發明所屬技術領域中具
25 有通常知識者參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或
26 分析方法，應可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至例
27 如系爭專利請求項1至8總括的「wt%a係3.25重量%至3.6重
28 量%」範圍，故此部分並無參加人所指無法為說明書所支
29 持等情。

30 六、原證2不足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性：

01 (一)原證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

02 1.原證2與系爭專利請求項1之比對：

03 系爭專利請求項1與原證2相較，原證2說明書：

04 (1)原證2說明書第3/13頁揭示一種特別適於在STI應用中進
05 行拋光和平面化的拋光墊，例如用於HDP/SiN、TEOS/Si
06 N或SACVD/SiN，所述拋光墊包括聚合物基體，且聚合物
07 拋光墊之頂部拋光表面包括聚合物拋光粗糙結構，用以
08 控制拋光墊的晶片基板去除速率；

09 (2)第5/13頁揭示所述拋光墊的具體拋光性質部分是源自預
10 聚物多元醇和多官能異氰酸酯的預聚物反應產物，所述
11 預聚物產物用固化劑固化形成拋光墊，所述聚合物可以
12 用來形成多孔的拋光墊，孔隙包括填充了氣體的微粒
13 等，所述拋光墊中孔隙或填料的濃度為0.2-70體積%，
14 且所述孔隙或填料微粒的重量平均直徑為1-100微米，
15 高孔隙與小孔徑的組合有助於減小缺陷度，將孔隙率保
16 持在40-60%對於減小缺陷度是特別有效的；

17 (3)第8/13至9/13頁揭示實施例1，其中聚合物拋光墊材料
18 是通過將各種量的異氰酸酯作為聚氨酯預聚物與4,4'-
19 亞甲基-二-鄰氯代苯胺（MBCA）相混合製備的，具體來
20 說，各種甲苯二異氰酸酯（TDI）與聚四亞甲基醚二醇
21 （PTMEG）預聚物提供了具有不同的性質的拋光墊，在
22 所述預聚物與增鏈劑混合之前或之後，將聚氨酯/多官
23 能胺混合物與空心聚合物微球體（AkzoNobel製造的EXP
24 ANCEL®551DE20d60或551DE40d42）混合，所述微球體的
25 重量平均直徑為15-50微米，5-200微米，表1則顯示具
26 有不同的化學計量比和各種聚合物微球體含量的聚氨酯
27 澆注物，其中製劑B-1至B-3之預聚物NCO%為8.75至9.0
28 5%，固化劑：NCO之比為85，EXPANCEL®551DE20d60微球
29 體添加量介於1.07至3.21重量%間，而該微球體固有地
30 具備約60g/L之密度（此參舉發證據4即CN1914241A說明

書第9/12頁、舉發證據5即CN1558748A說明書第8/35
頁、舉發證據6即CN1476987A說明書第31/40頁等即
明）。

2.由上可知，原證2揭示一種適用於研磨含有介電材料（HD
P/SiN、TEOS/SiN或SACVD/SiN）之圖形化半導體基板的研
磨墊【要件1A】，該研磨墊係包括聚合物基質及位於該聚
合物基質內之中空聚合物顆粒（EXPANCEL®551DE20d60微
球體），該聚合物基質係NH₂對NCO之化學計量比率為85%
（製劑B-1至B-3之固化劑：NCO之比為85）之固化劑（MBC
A）與異氰酸酯（TDI）封端之聚四伸甲基醚二醇（PTME
G）之聚胺酯反應產物，該異氰酸酯封端之聚四伸甲基醚
二醇具有8.75重量%至9.05重量%範圍之未反應NCO（製劑B
-1至B-3之預聚物NCO%為8.75至9.05%），該固化劑含有將
該異氰酸酯封端之聚四伸甲基醚二醇固化以形成該聚合物
基質之固化胺【要件1B】，該研磨墊具有40體積%至60體
積%之孔隙率（孔隙率保持在40-60%），而原證2使用之中
空聚合物顆粒及預聚物等均與系爭專利說明書所述者完全
相同，固化後自會得到閉合單元結構分布於聚合物基質內
之型態，聚合基質形成環繞該閉合單元結構之連續網，且
該連續網具有粗糙化表面，能於研磨過程中捕獲矽砂顆粒
【要件1D】，又該中空聚合物顆粒的體積百分比孔隙率及
重量平均直徑減少研磨缺陷（高孔隙與小孔徑的組合有助
於減小缺陷度）【要件1E】。原證2雖揭示中空聚合物顆
粒具有15至50 μm 之重量平均直徑（551DE20d60微球體的
重均直徑15-50微米），以及中空聚合物顆粒之密度b係約
60g/L之平均密度（551DE20d60微球體的密度約60g/L）
【於此情形下，中空聚合物顆粒的含量wt%b應落入wt%a範
圍亦即3.25重量%至3.6重量%，方可成立系爭專利請求項1
所載等式】，然原證2具體例示之551DE20d60微球體添加
量wt%b係介於1.07至3.21重量%間，此與系爭專利請求項1

01 所述者未盡相符【要件1C】。系爭專利請求項1與原證2之
02 技術特徵比對如附表3所示。

03 3.基於前述比對，原證2揭示內容與系爭專利請求項1至少於
04 微球體含量之技術特徵存在差異，該等差異顯非僅在於文
05 字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，亦非為
06 相對應技術特徵的上、下位概念，故原證2不足以證明系
07 爭專利請求項1不具新穎性。

08 4.參加人主張可基於原證2的教示推算得出表4所示製劑B-
09 1、B-2及B-3用於製備具有孔隙率40%之拋光墊時所需微球
10 體的重量百分比，皆落在系爭專利請求項1所載「3.25重
11 量%至3.6重量%」範圍內，故原證2足證系爭專利請求項1
12 不具新穎性云云。惟查：

13 (1)依參加人114年5月21日所提行政訴訟參加答辯狀第17
14 頁、同年7月17日所提行政訴訟參加辯論意旨狀第13至
15 14頁所述「雖然舉發證據2/原證2之表4揭露……其中微
16 球體之重量百分比……未讀取系爭專利請求項1所載之
17 『wt%係3.25重量%至3.6重量%』，但查……通常知識
18 者可以理解，需要提高表4中所示製劑B-1、B-2和B-3中
19 的微球體之重量百分比……」（本院卷二第69、377至3
20 78頁），可知參加人之主張乃為：原證2實施例所示製
21 劑B-1、B-2和B-3未揭露系爭專利請求項1所載「3.25重
22 量%至3.6重量%」範圍，然通常知識者基於原證2之教示
23 可提高原證2實施例所示製劑B-1、B-2和B-3中的微球體
24 含量，再經參加人聲稱為通常知識之數個公式予以推演
25 計算，方與系爭專利請求項1之技術特徵為比對。

26 (2)上開過程先確認系爭專利請求項1與原證2所揭露技術內
27 容有所差異，繼而涉及對於差異技術特徵之修飾，並納
28 入參加人自述為公眾所知悉之先前技術予以推算，其論
29 理明顯逾越新穎性之比對判斷，要屬未洽，自無從憑此
30 佐證系爭專利請求項1已見於原證2。

01 (二)原證2不足以證明系爭專利請求項2至4不具新穎性：

02 系爭專利請求項2至4係請求項1之附屬項，包含請求項1之內
03 容而再為進一步界定。原證2不足以證明系爭專利請求項1不
04 具新穎性，已如前述，原證2自亦不足以證明依附請求項1並
05 具有進一步技術特徵之請求項2至4不具新穎性。

06 (三)原證2不足以證明系爭專利請求項5不具新穎性：

07 1.原證2與系爭專利請求項5之比對：

08 系爭專利請求項5與原證2相較可知，原證2揭示一種適用於
09 於研磨含有介電材料（HDP/SiN、TEOS/SiN或SACVD/SiN）
10 之圖形化半導體基板的研磨墊【要件5A】，該研磨墊係包
11 括聚合物基質及位於該聚合物基質內之中空聚合物顆粒
12 （EXPANCEL®551DE20d60微球體），該聚合物基質係NH₂對
13 NCO之化學計量比率為85%（製劑B-1至B-3之固化劑：NCO
14 之比為85）之固化劑（MBCA）與異氰酸酯（TDI）封端之
15 聚四伸甲基醚二醇（PTMEG）之聚胺酯反應產物，該異氰
16 酸酯封端之聚四伸甲基醚二醇具有8.75重量%至9.05重量%
17 範圍之未反應NCO（製劑B-1至B-3之預聚物NCO%為8.75至
18 9.05%），該固化劑含有將該異氰酸酯封端之聚四伸甲基
19 醚二醇固化以形成該聚合物基質之固化胺【要件5B】，該
20 研磨墊具有40體積%至60體積%之孔隙率（孔隙率保持在40
21 -60%），而原證2使用之中空聚合物顆粒及預聚物等均與
22 系爭專利說明書所述者完全相同，固化後自會得到閉合單
23 元結構分布於聚合物基質內之型態，聚合基質形成環繞該
24 閉合單元結構之連續網，且該連續網具有粗糙化表面，能
25 於研磨過程中捕獲燻矽顆粒【要件5D】，又該中空聚合物
26 顆粒的體積百分比孔隙率及重量平均直徑減少研磨缺陷
27 （高孔隙與小孔徑的組合有助於減小缺陷度）【要件5
28 E】。原證2雖揭示中空聚合物顆粒具有15至50 μm 之重量
29 平均直徑（551DE20d60微球體的重均直徑15-50微米），

以及中空聚合物顆粒之密度係約60g/L之平均密度（551DE 20d60微球體的密度約60g/L）【於此情形下，中空聚合物顆粒的含量wt%b應落入wt%a範圍亦即3.25重量%至3.6重量%，方可成立系爭專利請求項1所載等式】，然原證2具體例示之551DE20d60微球體添加量wt%b係介於1.07至3.21重量%間，此與系爭專利請求項5所述者未盡相符【要件5C】。系爭專利請求項5與原證2之技術特徵比對如附表4所示。

2.基於前述比對，原證2揭示內容與系爭專利請求項5於微球體含量之技術特徵存在差異，該等差異顯非僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，亦非為相對應技術特徵的上、下位概念，故原證2不足以證明系爭專利請求項5不具新穎性。

3.參加人主張系爭專利請求項5與請求項1之差異技術特徵亦已為原證2所揭示，故原證2足證系爭專利請求項5不具新穎性云云。惟同前所述，關於參加人主張原證2實質隱含揭示「wt%a係3.25重量%至3.6重量%」技術特徵，其所憑推論過程已逾越新穎性之比對判斷，要屬未洽，故參加人仍無從以原證2證明具有該技術特徵之系爭專利請求項5不具新穎性。

(四)原證2不足以證明系爭專利請求項6至8不具新穎性：

系爭專利請求項6至8係請求項5之附屬項，包含請求項5之內容而再為進一步界定。原證2不足以證明系爭專利請求項5不具新穎性，已如前述，原證2自亦不足以證明依附請求項5並具有進一步技術特徵之請求項6至8不具新穎性。

七、原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性：

(一)確定該發明通常知識者於專利申請時之技術水準：

依系爭專利說明書所載之「技術領域」及「發明內容」，可知其係屬「研磨或平面化半導體基板之研磨墊」相關技術領域，故該所屬技術領域中具有通常知識者即具有研磨或平面化半導體基板之研磨墊相關技術領域之一般知識及普通技能之人，且該研磨墊所屬技術領域中具有通常知識者能以先前技術為基礎，來理解系爭專利之發明，即能符合本件所稱該所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準。本件專利是否具進步性，仍由上開具有相關技術之人依申請前之先前技術來模擬具有通常知識者之知識水準，以判斷系爭專利是否具進步性。從而，本件依系爭專利申請前之原證2至6作為判斷系爭專利有無具進步性之依據，自依前揭技術內容已能確立該所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準。

(二)原證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.系爭專利請求項1與原證2所揭露內容間之差異：

系爭專利請求項1與原證2之比對，如前第柒、六、(一)、1.、2.項及附表3所示。

2.原證2說明書第9/13頁揭示聚合物微球體的量的增加通常會降低物理性質，但是會改進拋光缺陷度性能，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依據性能需求而調配聚合物微球體含量；第5/13頁記載拋光墊中孔隙或填料的濃度為0.2-70體積%，高孔隙與小孔徑的組合有助於減小缺陷度，將孔隙率保持在40-60%對於減小缺陷度是特別有效的等語，亦已教示可適度增加聚合物微球體含量以減小缺陷度，蓋因同一聚合物微球體（密度固定）之重量%增加，其體積%乃至於拋光墊的孔隙率亦隨之增加。發明所屬技術領域中具有通常知識者為優化拋光墊之性能，利用申請時之通常知識，即能將原證2所例示製劑B-1之微球體添加量wt%b（3.21重量%）簡單地進行修飾而調整為例如3.25重量%至3.6重量%範圍內者，完成系爭專利請求項1之發明，僅屬簡單變更，具有否定進步性之因素無訛，且原證

2對於此等簡單變更存在有教示建議業如前述，更堪認屬有利之情事；相較於先前技術，系爭專利請求項1所界定比例範圍「3.25重量%至3.6重量%」實未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2應能輕易完成系爭專利請求項1之發明，原證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

3.原告主張原證2通篇說明書均未敘及3.25重量%、3.6重量%或介於其間之重量百分比，未明確記載或實質隱含系爭專利請求項1之「3.25重量%至3.6重量%」技術特徵，被告及訴願機關未以引證文件揭露之技術內容為準審查系爭專利請求項1之進步性，明顯有誤云云。惟：

(1)按申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性；其中，若申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之通常知識，即能預期得到該發明者，則該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知者，亦即能被輕易完成。準此，縱使一發明有部分技術特徵未為證據所明確記載或實質隱含，然若該發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之通常知識，而能預期得到包括該等差異技術特徵之發明整體時，仍應認定該發明不具進步性。原告以原證2未明確記載或實質隱含系爭專利請求項1之部分技術特徵為由，逕稱系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者無從依原證2輕易完成系爭專利請求項1之發明，係對進步性之判斷有所誤解，並非可採。

(2)原處分第12至13頁記載原證2（亦即舉發證據2）未揭示「wt%a是3.25-3.6wt%」之技術特徵，復進一步記載所

屬技術領域中具有通常知識者以原證2之技術內容為基礎（例如B-1製劑、聚合物微球體量的增加可改進拋光缺陷度性能等），可依需要簡單變更研磨墊中的中空聚合物顆粒含量，得到系爭專利請求項1所載研磨墊。易言之，原處分業已敘明系爭專利請求項1之發明與原證2雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，方認定系爭專利請求項1不具進步性，原處分之論理洵屬有據。

4.原告又主張依原證2第12頁（按：說明書第9/13頁）上下文可知，原證2關於「會改進拋光缺陷度性能」之描述僅係就其表1所揭示微球體含量範圍「1.07重量%~3.21重量%」而言，未擴及前開以外之範圍；原處分關於原證2第12頁及表5等處之解讀方式有誤，明顯未提出「清楚且足以令人信服之證據」云云。惟：

(1)實施例為具體實施方式，以呈現解決問題所採用的技術手段，從而原證2說明書第9/13頁所載「表1顯示了具有不同的化學計量比和各種聚合物微球體含量的聚氨酯澆注物的斷裂伸長率…另外，聚合物微球體的量的增加通常會降低物理性質，但是會改進拋光缺陷度性能」，應係基於原證2表1所示樣品及測試結果予以總括、推導所得技術性結論，並非僅描述比對原證2表1明確記載之樣品及測試結果，否則應無庸使用「通常」等用以表示概括之詞語，是以原處分所論「證據2下標第12頁最後1段揭示聚合物微球體的量的增加通常會降低物理性能，但是會改進拋光缺陷度性能」尚無原告所指之解讀有誤等情。

(2)因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀原證2後，當不致誤解所述「聚合物微球體的量的增加…會改進拋光缺陷度性能」必然僅限於「1.07重量%~3.21重量%」範圍，反可基於此等概括性的教示建議，將原

證2所例示之微球體添加量wt%b (3.21重量%) 簡單變更為例如3.25重量%至3.6重量%範圍內者，且預期對拋光缺陷度性能之改進有所助益。

(3)實則嘗試調整拋光墊各成分比例以優化拋光墊性能，本即為系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者利用執行例行工作、實驗的普通能力所能完成者，而如前所述，原證2說明書第9/13頁所載「聚合物微球體的量的增加……會改進拋光缺陷度性能」更足使所屬技術領域中具有通常知識者產生充分動機嘗試提高聚合物微球體的含量，從而此等有關係爭專利不具進步性之舉證即已達清楚且足以令人信服之程度無訛，是無論原證2表5是否表明微球體含量與研磨墊功效屬正相關，均無礙於系爭專利不具進步性之認定。

5.原告另主張依原證2表3明確揭示之製劑B平均撕裂強度可知，製劑B與實施例並非僅在於固化劑與NCO之化學計量有所差異，且製劑B與原證2發明目的牴觸，無法產生低缺陷度之拋光墊，已明確排除於原證2之發明云云。惟：

(1)原證2說明書第9/13頁記載「表1顯示了具有不同的化學計量比和各種聚合物微球體含量的聚氨酯澆注物的斷裂伸長率」，說明書第11/13頁則記載「表3顯示了由各種Adiprene聚氨酯預聚物和MBCA製備的未填充的塊狀高彈體的抗張和撕裂性質」，經比對可知，表1所例示製劑B-1等與表3所載製劑B至少在「聚合物微球體之有無」存在差異，是以應難逕由原證2表3中關於製劑B之測試結果表徵表1所述製劑B-1之物性。

(2)自原處分第9頁「證據2下標第12頁之表1中製劑B揭示……」及第13頁「證據2第12頁表1所示B-1製劑中551DE40d60微球體之孔隙含量(克/100克製劑)為3.21重量%(wt%a)，其與系爭專利請求項1所請3.25重量%至3.6重量%之範圍極為接近，而研磨墊中的中空聚合物顆

01 粒含量，係所屬技術領域中具有通常知識者可依需要予
02 以簡單變更者…」等處以觀，原處分係以原證2表1之製
03 劑B-1等為基礎，並認所屬技術領域中具有通常知識者
04 可依需要經簡單變更而輕易完成系爭專利請求項1之研
05 磨墊。而如前所述，原證2表3中關於製劑B之測試結果
06 並無足表徵表1所述製劑B-1之物性，是以原告執原證2
07 表3之製劑B平均撕裂強度等測試結果，主張製劑B-1等
08 與原證2發明目的牴觸而應予排除，其論據已非可採。

09 (3)縱認原證2表1之製劑B-1等的物性較製劑1-1等為差，屬
10 於原證2發明之比較例，然該製劑B-1之聚合物材料、空
11 心聚合物微球體、預聚物NCO%、固化劑：NCO之比、微
12 球體添加量重量%等技術內容已具體記載於原證2中，確
13 有被公開而可作為系爭專利申請時之先前技術無訛；再
14 者，即便製劑B-1之物性較差仍未必構成反向教示，原
15 證2之實質內容並未揭露製劑B-1等不可作為研磨墊或微
16 球體添加量不得增加，亦即沒有排除系爭專利之發明的
17 教示或建議，因此對於系爭專利之發明應未構成反向教
18 示，原處分之認定尚無違誤。

19 6.原告復主張系爭專利請求項1具有無法預期之功效，原處
20 分以系爭專利說明書中實施例與比較例之比較結果認定系
21 爭專利之發明不具無法預期功效，顯然有誤，實則系爭專
22 利說明書表2顯示配方1之晶片規格不一致性較配方B低，
23 第1至3圖顯示捕獲燻矽顆粒等功效，且系爭專利可顯著降
24 低缺陷率，由原證7表5可知微球含量為3.36重量%之研磨
25 墊係具有較低的缺陷率，移除率增加的同時缺陷率卻降
26 低，此種情形並不尋常，另原證8基於原證9及10所呈數據
27 表明由具有聚四伸甲基醚二醇主鏈且NCO為8.75至9.05重
28 量%、並負載有3.25至3.6重量%空心聚合物顆粒的預聚物
29 製成的拋光墊，其拋光性能意外地提高云云。惟：

01 (1)原告雖援引最高行政法院103年度判字第705號判決意旨
02 為據，然該判決係認其所涉專利申請專利範圍第1項與L
03 ipofectamine 2000轉染試劑之技術手段既屬不同，即
04 不得僅以二者之功效高低，遽謂該案所涉專利申請專利
05 範圍第1項不具進步性。易言之，該判決係認定在所請
06 發明與先前技術之技術手段顯然不同時（未有否定進步
07 性之因素時），即便所請發明之功效低於先前技術（不
08 存在肯定進步性之因素），仍非得遽認所請發明不具進
09 步性。然本件所屬技術領域中具有通常知識者可依原證
10 2之技術內容經簡單變更完成系爭專利請求項1之發明，
11 業如前述，亦即本件已有否定進步性之因素，此與前開
12 判決之情形顯然不同，因此，若本件未有肯定進步性之
13 因素存在（例如系爭專利請求項1對照先前技術未具有
14 無法預期之功效），經綜合考量仍應判斷系爭專利請求
15 項1之發明不具進步性。

16 (2)關於原處分第13頁所論「由系爭專利說明書所載具體實
17 施例（配方1及2為3.36%）與比較例（配方B為3.21%）
18 來看，並未具有無法預期之功效」，經比對系爭專利說
19 明書第17頁表1配方B及原證2說明書第9/13頁表1製劑B-
20 1可知，二者之聚合物材料、空心聚合物微球體、預聚
21 物NCO%、固化劑：NCO之比、微球體添加量重量%等均相
22 符，當可預期系爭專利比較例配方B與原證2表1製劑B-1
23 應具有相當物性，則前開論述實際上即足以表徵系爭專
24 利請求項1所請發明對照原證2表1製劑B-1未具有無法預
25 期之功效，故原處分認定系爭專利不具進步性，洵屬有
26 據。

27 (3)原告雖進一步提出系爭專利之發明具有低晶片規格不一
28 致性、低缺陷率、增加移除率、捕獲燻矽顆粒等功效，
29 惟查，系爭專利說明書表2顯示實施例配方1、2（中空
30 聚合物球3.36重量%）之30秒移除率及60秒移除率均不

01 及配方B（中空聚合物球3.21重量%，相當於原證2表1製
02 劑B-1），配方2之NU%則遠大於配方B而顯示較高的晶片
03 規格不一致性，尚難肯認系爭專利之發明於晶片規格不
04 一致性、移除率等方面確具有有利功效，遑論無法預期
05 之功效。再者，原證2使用之中空聚合物顆粒及預聚物
06 等均與系爭專利說明書所述者完全相同，固化後當能獲
07 致相仿的燻矽親和性，從而亦難謂捕獲燻矽顆粒為系爭
08 專利對照原證2等先前技術所能產生之有利功效甚或無
09 法預期之功效。此外，原證2說明書第9/13頁揭示聚合
10 物微球體的量的增加會改進拋光缺陷度性能，是以將中
11 空聚合物球重量%自3.21重量%簡單變更為例如3.25重
12 量%至3.6重量%範圍內者時，降低缺陷率等功效仍非無
13 法預期。再觀原證7表5，實例1及2之微球體含量均為3.
14 36重量%，缺陷度分別為95及11，其中缺陷度為95者相
15 較於原證2所揭示「3.21重量%」之缺陷度108尚難謂有
16 顯著降低；即便著眼於最佳數據亦即缺陷度為11者，而
17 明顯較微球體含量2.25重量%或3.21重量%之缺陷度為
18 低，仍難佐證系爭專利所請「3.25重量%至3.6重量%」
19 範圍整體相較於原證2所揭示「3.21重量%」均有顯著降
20 低缺陷率之表現，特別是端點值3.25重量%僅係略高於
21 3.21重量%，尚無從以原證7表5為據而肯認系爭專利所
22 界定微球體含量範圍在「降低缺陷率」部分確實達成功
23 效的顯著提升。

24 (4)至原證8至10之聲明及所呈數據，該等內容並非系爭專
25 利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載，或
26 發明所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利申請時
27 之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容所能推導
28 者，尚難納入考量。退萬步言，縱使實際檢視原證8至1
29 0之內容，仍未見有具體數據可資佐證中空聚合物顆粒
30 含量為「3.25重量%至3.6重量%」相較於「3.21重量%」

究竟產生何種功效的顯著提升或新的功效、且對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言係無法預期者，尚難僅因系爭專利發明人片面主張「拋光性能意外地提高」等語，即肯認系爭專利對照先前技術（如原證2表1製劑B-1）確實具有無法預期之功效。

7. 綜上，原證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(三) 原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1. 通常知識者有結合原證2與其他引證之動機：

(1) 原證2揭示適於對半導體基板等進行平面化的拋光墊，所述拋光墊包括聚合物基體，所述拋光墊的具體拋光性質部分是源自預聚物多元醇和多官能異氰酸酯的預聚物反應產物，所述預聚物產物用固化劑固化形成拋光墊，聚合物拋光墊材料是通過將各種量的異氰酸酯作為聚氨酯預聚物與4,4'-亞甲基-二-鄰氯代苯胺（MBCA）相混合製備的，各種甲苯二異氰酸酯（TDI）與聚四亞甲基醚二醇（PTMEG）預聚物提供了具有不同的性質的拋光墊，在所述預聚物與增鏈劑混合之前或之後，將聚氨酯/多官能胺混合物與空心聚合物微球體混合。

(2) 原證3揭示適於對半導體基材等進行平面化的拋光墊，所述拋光墊包括拋光表面和聚合物基質，所述聚合物基質具有封閉的單元孔，聚合物拋光墊材料是通過將各種量的異氰酸酯作為氨基甲酸酯預聚物與4,4'-亞甲基-二-鄰氯代苯胺（MBCA）相混合製備的，各種甲苯二異氰酸酯（TDI）與聚四亞甲基醚二醇（PTMEG）預聚物提供了具有不同的性質的拋光墊，在所述預聚物與增鏈劑混合之前或之後，將氨基甲酸酯/多官能胺混合物與空心聚合物微球體混合。

01 (3)原證4揭示用於平整半導體基體的拋光墊，聚合物拋光
02 墊材料通過對預聚物在50℃下和對MBCA在116℃下，混
03 合不同含量的作為聚氨酯預聚物的異氰酸酯與4,4'-亞
04 甲基-雙-鄰氯苯胺[MBCA]而製備，各種甲苯二異氰酸酯
05 [TDI]與聚四亞甲基醚乙二醇[PTMEG]預聚物為拋光墊提
06 供了不同的性能，並可將中空聚合物微球添加至混合
07 物。

08 (4)原證5揭示含有泡沫敷料層的彈性手套，可用的聚氨酯
09 預聚物例如以商標HYPOL出售的預聚物。

10 (5)原證6揭示親水性發泡製品，含有異氰酸酯封端的聚醚
11 預聚物，能夠吸水的親水劑，含有醇的輔助劑，潤濕劑
12 以及水的就地反應產物，適用於實施本發明的異氰酸酯
13 封端的預聚物包括市售的HYPOL。

14 (6)原證2至4均係關於拋光墊之技術領域，具有技術領域之
15 關連性，且三者均係使聚合物基質中混合有中空聚合物
16 微球體所得結構，其功能或作用具有共通性；另原證2
17 至4均敘及甲苯二異氰酸酯（TDI）與聚四亞甲基醚二醇
18 （PTMEG）反應所得聚氨酯預聚物，此與原證5及原證6
19 所述異氰酸酯封端的聚醚預聚物亦有功能或作用之共通
20 性。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動
21 機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證
22 2、3及6。

23 2.原證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，
24 則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之
25 組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求
26 項1不具進步性。

27 (四)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及
28 5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項2
29 不具進步性：

30 1.原證2足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項2依附請求項1，進一步界定「其中，該研磨墊係具有44至54之蕭氏D硬度」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項1，又查原證2說明書第12/13頁揭示製劑B-1的蕭氏D硬度為50.4。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項2之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(五)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

1.原證2足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3依附請求項1，進一步界定「其中，該研磨墊係具有35體積%至55體積%之孔隙率」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項1，又查原證2說明書第5/13頁揭示將孔隙率保持在40-60%對於減小缺陷度是特別有效的。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項3之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項3不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

(六)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

1.原證2足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4依附請求項1，進一步界定「其中，該中空聚合物顆粒係具有10至30 μm 之重量平均直徑」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項1，又查原證2說明書第9/13頁揭示微球體的重量平均直徑為15-50微米。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項4之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項4不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(七)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項5

01 不具進步性：

02 1.原證2足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

03 (1)系爭專利請求項5與原證2所揭露內容間之差異：

04 系爭專利請求項5與原證2之比對，如前第柒、六、(三)、
05 1.項及附表4所示。

06 (2)如前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者為優化
07 拋光墊之性能，利用申請時之通常知識，即能將原證2
08 所例示製劑B-1之微球體添加量wt%b (3.21重量%)簡單
09 地進行修飾而調整為例如3.25重量%至3.6重量%範圍內
10 者，是以亦可完成系爭專利請求項5之發明，僅屬簡單
11 變更，具有否定進步性之因素無訛，且原證2對於此等
12 簡單變更存在有教示建議業如前述，更堪認屬有利之情
13 事；相較於先前技術，系爭專利請求項5所界定比例範
14 圍「3.25重量%至3.6重量%」實未見有產生無法預期之
15 功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中
16 具有通常知識者依原證2應能輕易完成系爭專利請求項5
17 之發明，原證2足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

18 (3)原告主張系爭專利請求項5同樣具有「wt%a為3.25重量%
19 至3.6重量%」之技術特徵，因此同樣具有進步性云云。
20 惟基於前述理由，系爭專利請求項5並未因「wt%a為3.2
21 5重量%至3.6重量%」之差異技術特徵而具有進步性，是
22 以原告此部分主張，並不足採。

23 2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組
24 合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項5不具
25 進步性：

26 (1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動
27 機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證
28 2、3及6。

29 (2)原證2足以證明系爭專利請求項5不具進步性，已如前
30 述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、

3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(八)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

1.原證2足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

系爭專利請求項6依附請求項5，進一步界定「其中，該研磨墊係具有44至54之蕭氏D硬度」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項5，又查原證2說明書第12/13頁揭示製劑B-1的蕭氏D硬度為50.4。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項6之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項6不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

(九)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

1.原證2足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

系爭專利請求項7依附請求項5，進一步界定「其中，該研磨墊係具有35體積%至55體積%之孔隙率」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項5，又查原證2說明書第5/13頁揭示將孔隙率

保持在40-60%對於減小缺陷度是特別有效的。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項7之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項7不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

(十)原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

1.原證2足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

系爭專利請求項8依附請求項5，進一步界定「其中，該中空聚合物顆粒係具有10至30 μm 之重量平均直徑」。承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依原證2輕易完成系爭專利請求項5，又原證2說明書第9/13頁揭示微球體的重量平均直徑為15-50微米。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依原證2亦能輕易完成系爭專利請求項8之發明。

2.原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

(1)承前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合原證2及3、原證2、3及4、原證2、3及5、及原證2、3及6。

(2)原證2足以證明系爭專利請求項8不具進步性，已如前述，則原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合自亦足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

八、綜上所述，系爭專利說明書記載明確且充分揭露而可據以實現，並未違反專利法第26條第1項規定；系爭專利請求項1至8記載明確且可為說明書所支持，並未違反專利法第26條第2項規定；原證2不足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性。惟經整體技術特徵比對，原證2、原證2及3之組合、原證2、3及4之組合、原證2、3及5之組合、及原證2、3及6之組合足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1至8舉發成立」之部分，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

捌、結論：

依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 9 月 9 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳端宜

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

01 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
02 逕以裁定駁回。

03 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
04 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
05 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
06

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關	

01

係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 114 年 9 月 19 日

03

書記官 邱于婷